

# HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD / IE000YDZG487 / A3C98L / HSBC Inv. Funds (LU)

<b>Aktuell 01.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
43,99 USD	weltweit	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



## Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

## Jahresperformance

2025	+57,10%
2024	+17,34%
2023	+68,42%
2022	-25,65%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.06.2026) USD 263,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026)	0,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.06.2026) USD 263,70 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	25.01.2022	HSBC Inv. Funds (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	18, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.assetmanagement.hsbc.lu			
Fondsmanager	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+24,60%	+95,38%	+88,55%	+195,91%	+179,29%	+319,14%	-	+335,24%
Performance p.a.	-	-	-	+196,80%	+67,36%	+61,16%	-	+40,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+195,91%	+67,12%	+61,23%	-	+40,16%
Sharpe Ratio	32,30	8,81	10,65	6,90	2,14	2,12	-	1,29
Volatilität	38,10%	31,87%	33,46%	28,18%	30,38%	27,84%	-	29,38%
Schlechtester Monat	-	-10,94%	-10,94%	-10,94%	-10,94%	-10,94%	-18,28%	-18,28%
Bester Monat	-	+37,94%	+37,94%	+37,94%	+37,94%	+37,94%	+37,94%	+37,94%
Maximaler Verlust	-7,41%	-15,62%	-15,62%	-15,62%	-37,00%	-37,00%	-	-41,32%

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.06.2026 11:51

# HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD / IE000YDZG487 / A3C98L / HSBC Inv. Funds (LU)

## Investmentstrategie

Es kann jeweils nur ein von einem Unternehmen begebenes Wertpapier in den Index aufgenommen werden. Damit ein Unternehmen in den Index aufgenommen werden kann, gelten die folgenden Zulassungskriterien: ein Unternehmen muss Bestandteil des Hauptindex sein und das ihm zugewiesene Land muss dem AsienPazifik-Raum, Europa oder den Vereinigten Staaten zugeordnet sein, ein Unternehmen muss gemäß der Industry Classification Benchmark (wie von FTSE International Limited definiert) dem Teilssektor Halbleiter oder dem Teilssektor Produktionstechnologieausrüstung zugeordnet sein, und eine Marktkapitalisierung von mindestens 150 Millionen USD haben. Der Indexanbieter wählt die Bestandteile halbjährlich aus, und es können Schwellenwerte angewendet werden, um die Beteiligung an Geschäftstätigkeiten wie umstrittenen Waffen, der Förderung von Kraftwerkskohle und der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle zu bestimmen. Für die Gewichtung der Indexbestandteile mit den fünf größten Marktkapitalisierungen besteht eine Obergrenze von 8 %, die Gewichtung aller anderen Wertpapiere wird auf 4 % begrenzt. Die oben genannten Emissionsobergrenzen werden vierteljährlich im Einklang mit der Neugewichtung des Index umgesetzt.

## Fondsspezifische Informationen

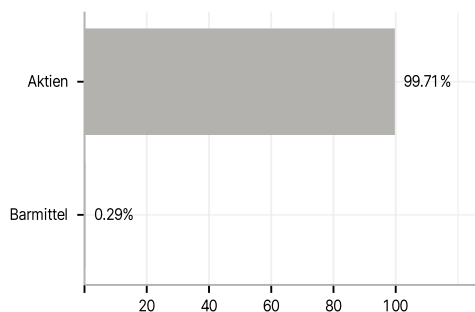
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten oder von einem der folgenden supranationalen oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. OECD-Regierungen (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung von Indien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, The African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority oder Straight-A Funding LLC..

## Investmentziel

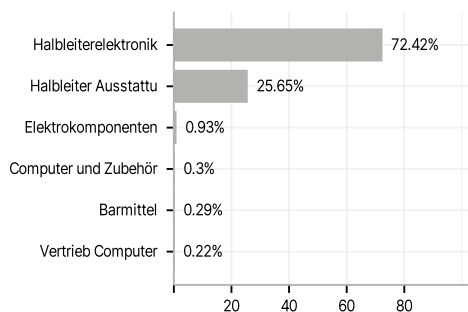
Der Fonds strebt an, die Erträge des Nasdaq Global Semiconductor Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.

## Veranlagungsstruktur

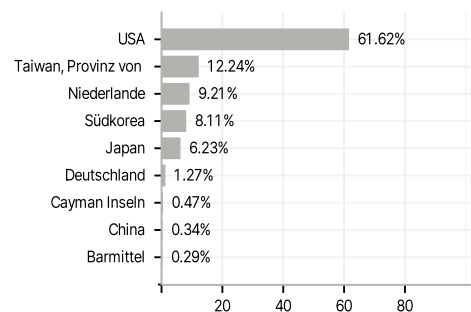
### Anlagearten



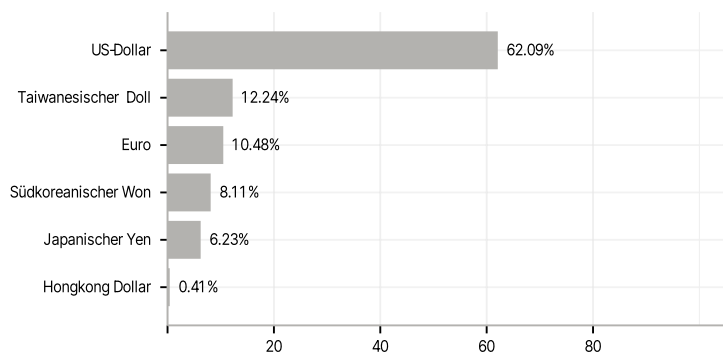
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

